
	<h2 style="color: red;">FQP630TSTU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQP630TSTU</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP630TSTU.pdf 2.FQP630TSTU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 900 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP630TSTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 9A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	900 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 9A (Tc) 78W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	78W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	550pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP630TSTU ist neu im Original, Suche FQP630TSTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP630TSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP630TSTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP60N10 KERSEMI KERSEMI TO-220</p>	 <p>FQP6N15 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 6.4A TO-220</p>	 <p>FQP60NF06 FAIRCHILD FAIRCHILD TO-220</p>	 <p>FQP65N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 65A TO-220</p>
 <p>FQP60N06 FAIRCHI FAIRCHI TO-220</p>	 <p>FQP630 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>	 <p>FQP630TSTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>	 <p>FQP630 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQP4N20L	↔ FQP4N20L	⇒ FQP4N60C	D FQP4N65C	↔ FQP4N90C
⊕ FQP4N90C	⊕ FQP50N03	D FQP50N03C	⇒ FQP50N06	↔ FQP50N06
⊕ FQP50N06L	⊕ FQP50N06L	⊕ FQP50N08	↔ FQP55N06	↔ FQP55N06
D FQP55N10	⊕ FQP55N10	⊕ FQP58N08	⊕ FQP58N08	↔ FQP5N20L
⇒ FQP5N20L	↔ FQP5N50C	⊕ FQP5N50C	⊕ FQP5N60C	↔ FQP5N60C
↔ FQP630TSTU	⇒ FQP65N06	D FQP65N06	⊕ FQP6N40C	⊕ FQP6N40C
⊕ FQP6N40CF	D FQP6N40CF	⇒ FQP6N50C	↔ FQP6N50C	↔ FQP6N60C
⊕ FQP6N60C	⊕ FQP6N80C	↔ FQP6N80C	⇒ FQP6N90C	↔ FQP6N90C
⊕ FQP70N03L	⊕ FQP70N06	⊕ FQP70N06C	D FQP70N08	↔ FQP70N08
↔ FQP70N10	⊕ FQP70N10	⊕ FQP7N10L	⊕ FQP7N10L	↔ FQP7N20L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited